両面受光-裏面電極型結晶シリコン太陽電池の作製と評価

<u>立花</u>福久、白澤勝彦、高遠秀尚 産業技術総合研究所再生可能エネルギー研究センター太陽光チーム

n-type Si wafer

Fig. 1 Bifacial IBC solar cell.

Reflected light





✓細線電極により、裏面からの光取り込みが可能(両面受光型)

000

⇒需要の高まりが予想される本構造のこれまでの開発状況について報告を行なう。





Fig. 4 IQE line scan profiles at fingers (a) pitch 1200 µm, (b) pitch 1600 µm, (c) pitch 2200 µm and (d) pitch 2800 µm.

 ✓エミッタおよびBSF領域の比率を固定 し(3:1)、ピッチを変更した際のIQEの 変化として(図4),ピッチが大きくなるに つれて、BSF領域においてIQEは低 下した。これは電気的遮蔽損失の増 加によるものと考えられる。
✓ピッチとV_{oc}およびFFの関係(図5)につ いては、ピッチが狭いほど高いFFが 得られた。V_{oc}はほぼ一定であった。 ピッチの増加によるFFの低下は直列 抵抗の増加によるものと考えられる。



Fig. 5 V_{oc} and FF for several pitch samples

ロス解析結果

TABLE I: SURFACE RECOMBINATION PROPERTIES USING SYMMETRIC SAMPLE

Region	Equivalent J_o [fA/cm ²]	Area fraction in	$J_{\it 0}$ in bifacial IBC
		bifacial IBC	[fA/cm ²]
Emitter	$50~\pm~6$	0.748	37.40
\mathbf{BSF}	$293~\pm~10$	0.141	41.45
\mathbf{FSF}	$84~\pm~20$	1	84
Bulk	$60~\pm~5$	1	60
Gap	$500~\pm~50$	0.032	15.82
Total	-	-	238.68

Equivalent J_0 were measured by QSSPC using the symmetric samples.

 ✓両面対象サンプルにおける各領域の表面再結合特性結果は表1の通り。
✓得られたセルの電流及び電圧から求めたセル全体のJ₀は330 fA/cm²であり、 表1の合計との差が電極領域におけるJ₀である(=91.32 fA/cm²)。
✓セル全体のJ₀に対して約5割の損失が電極およびFSF領域で発生しており、 高効率化のためにはこれらの領域における再結合特性の改善が必要となる。



まとめ

✓エミッタ領域とBSF領域の比率を固定し、ピッチを変更することで、裏面構造がセル特性に与える影響を評価した。
✓ピッチが大きくなるにつれて、電気的遮蔽損失によってIQEは低下し、直列抵抗の増加によってFFは低下した。また、V_{oc}には大きな変化は見られなかった。このことから、高いセル特性を得るためには狭いピッチでの設計が必要となる。
✓ロス解析結果から、高効率化のためには電極及びFSF領域における再結合特性の改善が必要である。
✓詳細な実験条件等は Jpn. J. Appl. Phys. 59 (2020) 116503 に記載。
謝辞
本研究は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の支援のもとに実施されました。関係各位に感謝申し上げます。

